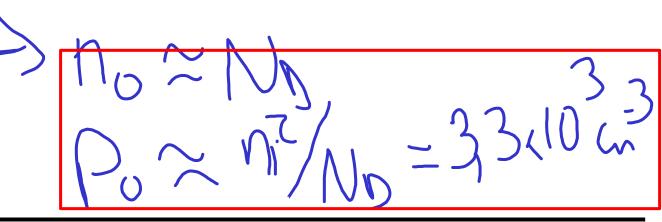
## [86.03/66.25] Dispositivos Semiconductores 1er Cuatrimestre 2020

## Física de Semiconductores

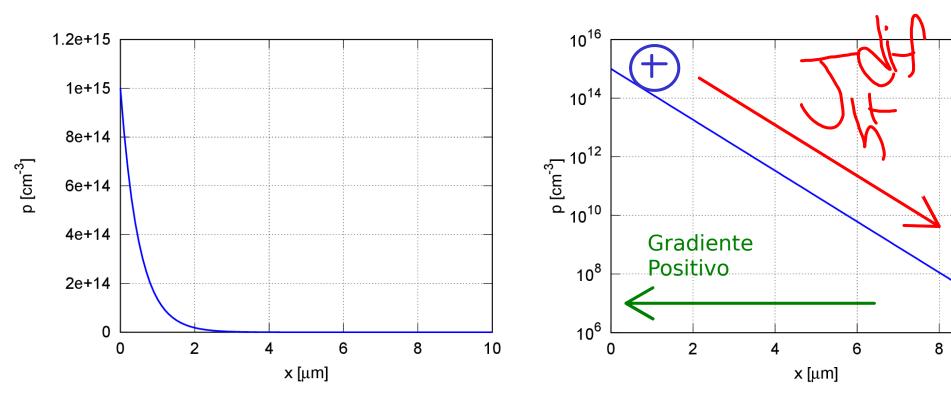
- 1. Concentración de portadores, movilidad y conductividad
- 2. Corriente de difusión
- 3. Relaciones de Boltzmann y diferencia de potencial

A una barra de Si con un dopaje  $N_D = 3 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$  de largo  $L = 10 \, \mu\text{m}$  a temperatura ambiente, se le genera un exceso de portadores minoritarios según  $\Delta f(x) = 10^{15} \, \text{cm}^{-3} \, \text{exp}(-x / 0.5 \, \mu\text{m})$ , resultando en un perfil de portadores  $f(x) = f_0 + \Delta f(x)$ . Calcular la densidad de corriente de minoritarios en  $x = 0.5 \, \mu\text{m}$ .

 $N_{5} \rightarrow Maye$  M,N



$$p(x) = p_0 + \Delta p(x); \Delta p(x) = 10^{15} \text{ cm}^{-3} \exp(-x / 0.5 \mu\text{m}).$$



10

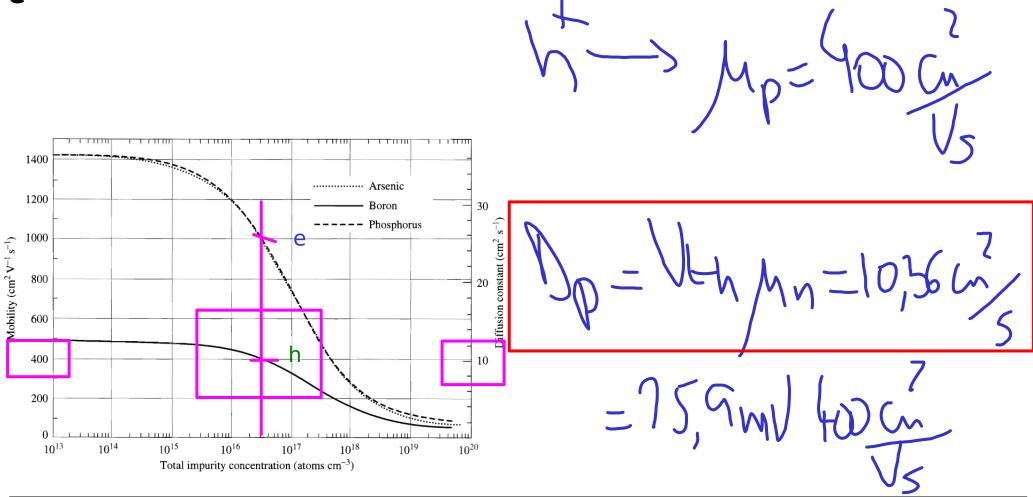
$$N_D = 3 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$
;  $L = 10 \text{ }\mu\text{m}$ 

$$p_0 = 3.3 \times 10^3 \text{ cm}^{-3}; \Delta p(x) = 10^{15} \text{ cm}^{-3} \exp(-x / 0.5 \mu\text{m})$$

Relación de Einstein

$$\frac{1}{2} \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \frac{$$

## ¿Cuál es la constante de difusión?



## Cálculos finales

$$J_p = -q D_p \frac{\partial p(x)}{\partial x}$$

$$J = 1.6 \times 10^{-19} C$$

$$q=1.6\times10^{-19}$$
C  
 $D_p=10.36 \text{ cm}^2/\text{s}$ 

$$\frac{\partial p}{\partial x} = -\frac{10^{15} \text{ cm}^{-3}}{0.5 \times 10^{-4} \text{ cm}} \exp\left(-\frac{x}{0.5 \times 10^{-4} \text{ cm}}\right)$$

